

## AIX G5 WW C - AIXTRON präsentiert neue Produktionsanlage für Siliziumkarbid

Vollautomatische Planetenanlage ermöglicht Großserienfertigung von leistungsstarker SiC-Leistungselektronik zur Förderung globaler Megatrends

**Herzogenrath, 30. September 2019** – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, hat im Rahmen der derzeit in Kyoto (Japan) stattfindenden [International Conference on Silicon Carbide and Related Materials](#) (ICSCRM) offiziell die neue AIX G5 WW C-Anlage für die Großserienproduktion von Epitaxie-Wafern der nächsten Generation aus Siliziumkarbid (SiC) vorgestellt. AIXTRON hat für die Anlage bereits Aufträge von mehreren Kunden erhalten und darüber hinaus Demonstrationen für weitere Kunden erfolgreich durchgeführt.

Siliziumkarbid ist ein wichtiger Baustein moderner Leistungselektronik-Systeme, die derzeit in Elektrofahrzeugen der nächsten Generation eingesetzt werden. Die neue Technologie ermöglicht sowohl kompakte und leistungsstarke On-Board-Ladegeräte als auch effiziente Wechselrichter, welche die entscheidende Komponente im elektrischen Antriebsstrang von Autos bilden.

Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE, sagt: "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach SiC-Leistungselektronik in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Bis 2023 rechnet man für den Markt für Leistungsbaulemente mit einem Volumen von mehr als 10 Mrd. USD, wovon 1-2 Mrd. USD auf hocheffiziente Bauelemente aus Siliziumkarbid entfallen werden. Unsere kosteneffiziente Epitaxie-Depositionsanlage unterstützt die Hersteller von SiC-Bauelementen im Wettlauf um den Gewinn von Marktanteilen zulasten siliziumbasierter Leistungselektronik-Bauelemente. Damit unterstützt AIXTRON die globalen Trends zu grüner Energie in den Bereichen Elektromobilität, Wind- und Solarenergie sowie in hocheffizienten Motorantrieben."

Basierend auf AIXTRONs bewährter Planetenreaktor®-Plattform und ausgestattet mit einem hochmodernen Wafer-Transfersystem für den Kassettenbetrieb („Cassette-to-Cassette“, C2C) bietet die vollautomatische AIX G5 WW C die größte Kapazität und den höchsten Durchsatz der Branche. Zunächst mit dem Angebot einer 8x6-Zoll-Konfiguration sowie der Möglichkeit die Wafer einzeln zu steuern, adressiert die Anlage die Herausforderung hinsichtlich der Herstellungskosten von SiC-Bauelementen: Die AIX G5 WW C reduziert die Epitaxie-Kosten von SiC-Bauelementen auf ein Minimum unter gleichzeitiger Beibehaltung einer exzellenten Produktionsqualität. Darüber hinaus ist die AIX G5 WW C kompatibel mit Fabriken in der

---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com) WEB [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com)

Siliziumindustrie und ermöglicht so die Integration der Herstellung von SiC-Epiwafern in bestehende Räumlichkeiten und Produktionslinien.

"Wir bei AIXTRON freuen uns, unseren Partnern und Kunden eine leistungsstarke Anlage zur Herstellung hochwertiger Siliziumkarbid-Bauelemente zur Verfügung stellen zu können. Die AIX G5 WW C beinhaltet nicht nur die automatisierte Beladung mit Wafern im Kassettenbetrieb und den Weitertransport der Wafer unter hohen Temperaturen, sondern berücksichtigt auch die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden in der Halbleiterindustrie", sagt Dr. Frank Wischmeyer, Vice President Business Development & Marketing Power Electronics bei AIXTRON.

## Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT<sup>®</sup>, AIXTRON<sup>®</sup>, APEVA<sup>®</sup>, Atomic Level Solutions<sup>®</sup>, Close Coupled Showerhead<sup>®</sup>, CRIUS<sup>®</sup>, EXP<sup>®</sup>, EPISON<sup>®</sup>, Gas Foil Rotation<sup>®</sup>, Optacap<sup>™</sup>, OVPD<sup>®</sup>, Planetary Reactor<sup>®</sup>, PVPD<sup>®</sup>, STEXS<sup>®</sup>, TriJet<sup>®</sup>

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com) verfügbar.

## Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

---

## Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com) WEB [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com)